

東芝インテリジェントパワーデバイス シリコンモノリシックパワーMOS型集積回路

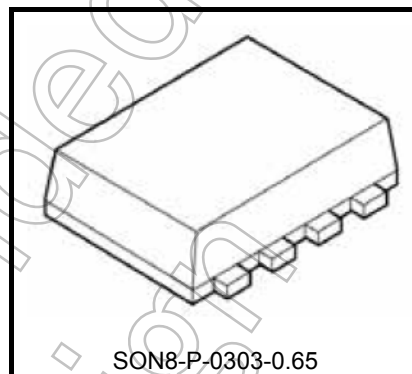
# TPD7102F

## 1 出力ハイサイド n-ch パワーMOS FET ゲートドライバ

TPD7102Fは1chのハイサイドスイッチ用n-chパワーMOS FETゲートドライバです。チャージポンプ回路を内蔵しており、大電流アプリケーションのハイサイドスイッチを容易に構成することができます。

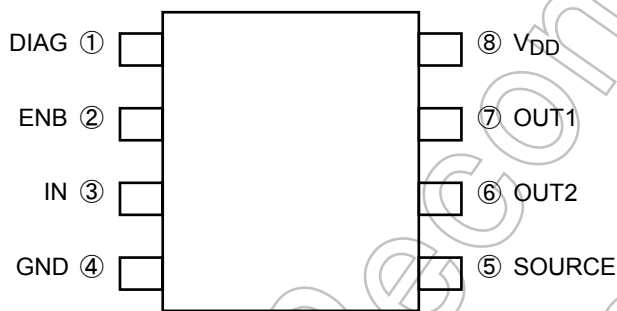
### 特長

- チャージポンプ回路を内蔵しています。
- 外付けパワーMOSFETのゲート・ソース間電圧診断機能を内蔵しています。
- 外囲器は小型、面実装タイプPS-8で梱包形態はエンボステーパーピングです。



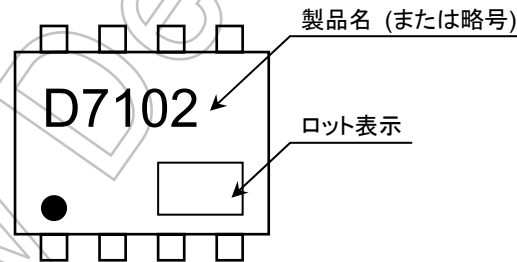
SON8-P-0303-0.65  
質量: 0.017g (標準)

### ピン接続



(TOP VIEW)

### 現品表示



・正面から見てマーク左下のドット(●)が1番端子を示しています。

※ ロット No.表示説明  
3桁の算用数字で構成する。



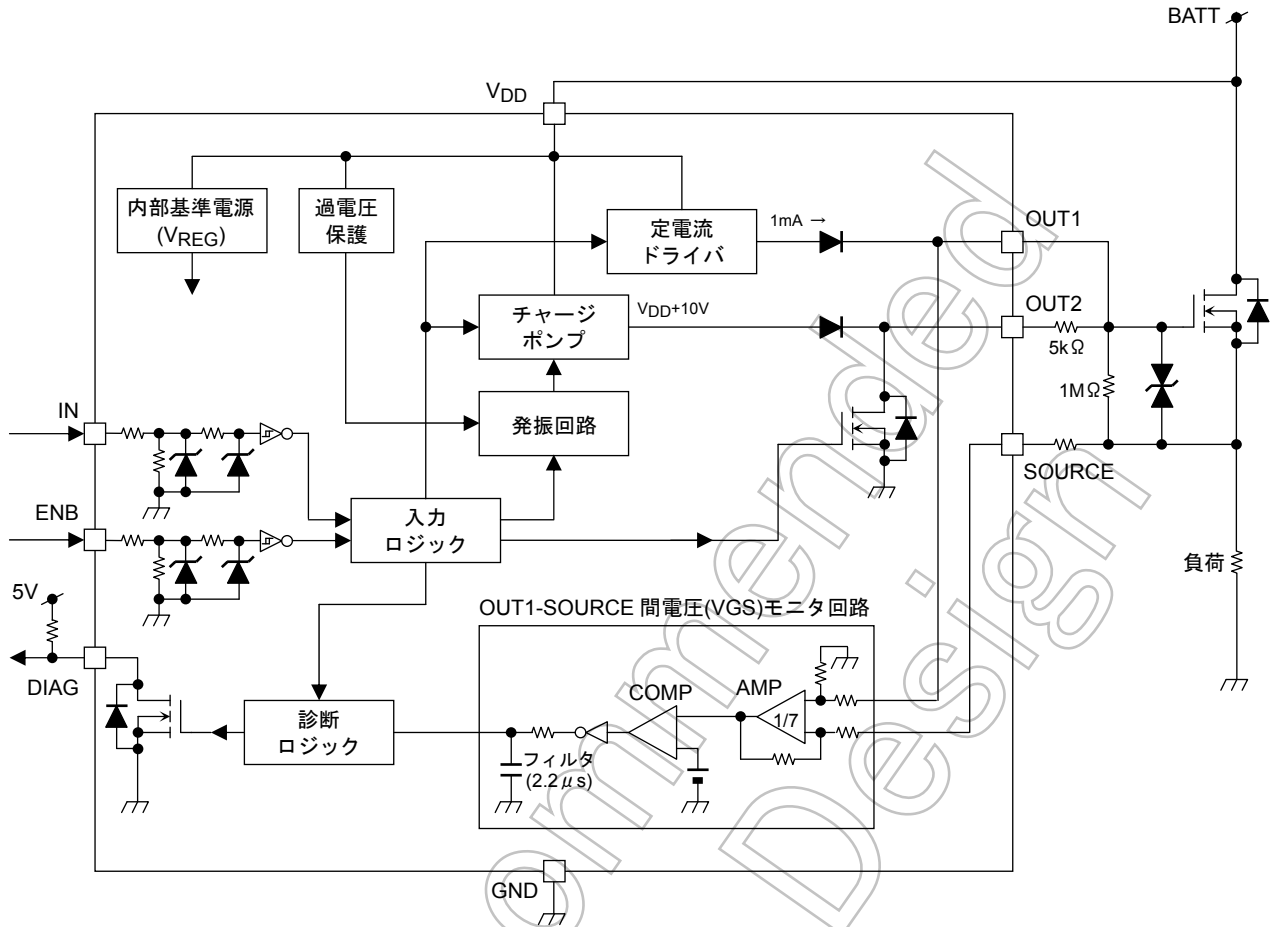
製造週コード: 1月第1木曜の週を第1週01とし、以降52または53まで  
製造年コード: 西暦の末尾1桁

本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。  
RoHS 指令とは、「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限(RoHS)に関する2011年6月8日付けの欧州議会および欧州理事会の指令(EU指令2011/65/EU)」のことです。

\* この製品はMOS構造ですので取り扱いの際には静電気にご注意ください。

製品量産開始時期  
2010-03

ブロック図／応用回路例

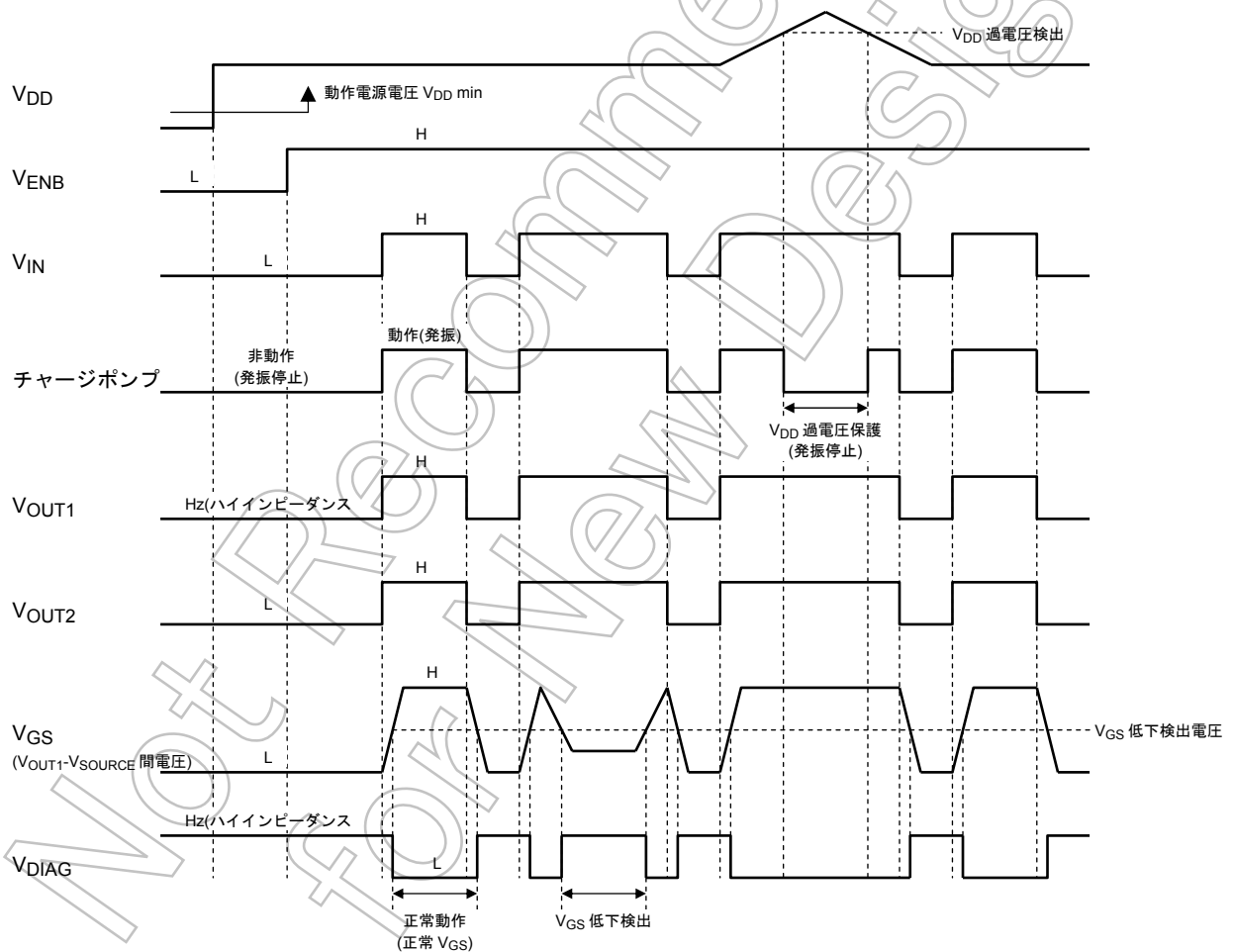


Not Recommended for New

## 端子説明

端子番号	記号	端子の説明
1	DIAG	診断出力端子。N-ch オープンドレイン構造。
2	ENB	イネーブル端子。プルダウン抵抗内蔵。VENB=L 時は OUT1 は Hz、OUT2=L レベルとなります。
3	IN	入力端子。プルダウン抵抗内蔵。VIN=VENB= “H” 時に出力(OUT1,OUT2)が “H” になります。
4	GND	接地端子。
5	SOURCE	外付けパワー-MOSFET のソース電圧モニタ端子。
6	OUT2	出力端子 2。
7	OUT1	出力端子 1。
8	VDD	電源端子。

## タイミングチャート



注 1 : IN、ENB への H 入力は V<sub>DD</sub> へ動作電源電圧範囲条件印加後としてください。

## 真理値表

IN 信号	ENB 信号	チャージポンプ回路	VOUT1	VOUT2	VGS	DIAG 出力	モード
L	L	発振停止	Hz	L	VGS=H	Hz	正常時 (VDD=7~18V)
H	L		Hz	L		Hz	
L	H		Hz	L		Hz	
H	H	発振	H	H	L		
L	L	発振停止	Hz	L	VGS=L	Hz	
H	L		Hz	L		Hz	
L	H		Hz	L		Hz	
H	H	発振	H	H	Hz		
L	L	発振停止	Hz	L	VGS=H	Hz	VDD 過電圧時 (VDD>18V)
H	L		Hz	L		Hz	
L	H		Hz	L		Hz	
H	H		H	H	L		
L	L		Hz	L	VGS=L	Hz	
H	L		Hz	L		Hz	
L	H		Hz	L		Hz	
H	H		H	H		Hz	

注 2 : VGS=H(VGS>VGSUV) / VGS=L(VGS≦VGSUV) ※VGS=VOUT1-VSOURCE 間電圧

注 3 : Hz : ハイインピーダンス

補足説明 : DIAG 出力は VIN=VENB=VGS=H 時のみ “L” を出力します。

Not Recommended for New Designs

## 絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位	備考
電源電圧	D C	V <sub>DD(1)</sub>	-0.3~25	V
	パルス	V <sub>DD(2)</sub>	35	V
入力電圧	V <sub>IN</sub>	-0.3~6	V	
診断出力電圧	V <sub>DIAG</sub>	-0.3~25	V	
診断出力電流	I <sub>DIAG</sub>	2	mA	
出力シンク電流 (DC)	I <sub>OUT2(+)</sub>	5	mA	シンク電流
SOURCE 端子負電圧	-V <sub>SOURCE</sub>	-7	V	t ≤ 0.1 μs, SOURCE 端子 10kΩ 抵抗接続時
許容損失 (注 4-a)	P <sub>D(1)</sub>	0.7	W	
許容損失 (注 4-b)	P <sub>D(2)</sub>	0.35	W	
動作温度	T <sub>opr</sub>	-40~125	°C	
ジャンクション温度	T <sub>j</sub>	150	°C	
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55~150	°C	

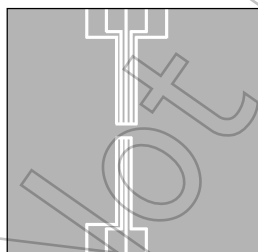
注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷(高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびデレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

## 熱抵抗特性

項目	記号	定格	単位
ジャンクション・周囲間熱抵抗	R <sub>th(j-a)</sub>	178.6(注 4-a)	°C / W
		357.2(注 4-b)	

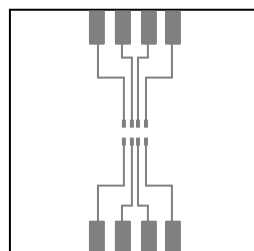
注 4:

(a) ガラスエポキシ基板



ガラスエポキシ基板  
材質: FR-4  
25.4mm × 25.4mm × 0.8mm

(b) ガラスエポキシ基板



ガラスエポキシ基板  
材質: FR-4  
25.4mm × 25.4mm × 0.8mm

電气的特性 (特に指定のない場合、 $T_j = -40 \sim 125^\circ\text{C}$ 、 $V_{DD} = 7 \sim 18\text{V}$ )

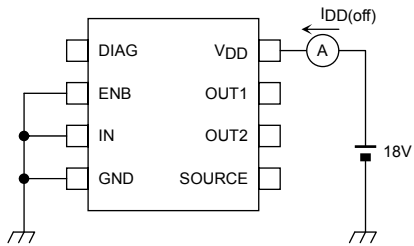
項目	記号	端子	測定条件	最小	標準	最大	単位
動作電源電圧 (チャージポンプ回路、入出力/ 診断回路動作)	$V_{DD(OPR)}$	$V_{DD}$	-	7	12	18	V
消費電流	$I_{DD(off)}$	$V_{DD}$	$V_{DD} = 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 0\text{V}$	-	0.35	2	mA
	$I_{DD(on)}$	$V_{DD}$	$V_{DD} = 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 5\text{V}$	-	3	8	mA
入力電圧	$V_{INH}$	IN, ENB	-	3.5	-	-	V
	$V_{INL}$		-	-	-	1.5	
入力電流	$I_{INH}$ , $I_{ENBH}$	IN, ENB	$V_{IN} = V_{ENB} = 5\text{V}$ ※各端子あたり	-	50	200	$\mu\text{A}$
	$I_{INIL}$ , $I_{ENBL}$		$V_{IN} = V_{ENB} = 0\text{V}$ ※各端子あたり	-1	-	1	
出力電圧	$V_{OUT1H}$	OUT1	$V_{DD} = 9 \sim 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 5\text{V}$ , $V_{SOURCE} = V_{DD}$ , OUT1-SOURCE 間 $1\text{M}\Omega$	$V_{DD} - 2.7$	$V_{DD} - 1$	$V_{DD}$	V
	$V_{OUT2H}$	OUT2	$V_{DD} = 9 \sim 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 5\text{V}$ , $V_{SOURCE} = V_{DD}$ , OUT2-SOURCE 間 $1\text{M}\Omega$	$V_{DD} + 6.0$	$V_{DD} + 10$	$V_{DD} + 12.5$	V
OUT2 シンク DMOS オン抵抗	$R_{ONOUT2L}$	OUT2	$V_{DD} = 7 \sim 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 0\text{V}$ , $I_{OUT2} = 1\text{mA}$	-	70	180	$\Omega$
OUT1 ハイレベル出力電流	$I_{OH1}$	OUT1	$V_{DD} = 9 \sim 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 5\text{V}$	-	-1.0	-0.15	mA
OUT1 出力リーク電流	$I_{OL1}$	OUT1	$V_{DD} = 9 \sim 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 0\text{V}$	-1	-	-	$\mu\text{A}$
OUT1 端子吸い込み電流	$I_{OUT1+}$	OUT1	$V_{OUT1} = 12\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 0\text{V}$	-	5	20	$\mu\text{A}$
OUT2 出力電流能力	$I_{OH2}$	OUT2	$V_{DD} = 9 \sim 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 5\text{V}$ , $V_{OUT2} = V_{DD} + 6\text{V}$	-	-100	-30	$\mu\text{A}$
診断出力リーク電流	$I_{DIAGH}$	DIAG	$V_{DD} = 7 \sim 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 0\text{V}$ $V_{DIAG} = 5\text{V}$	-	-	10	$\mu\text{A}$
診断出力電圧	$V_{DIAGL}$	DIAG	$V_{DD} = 7 \sim 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 5\text{V}$ $I_{DIAG} = 1\text{mA}$	-	-	0.4	V
VGS 低下検出 (OUT1-SOURCE 間電圧)	$V_{GSUV}$	OUT1, SOURCE	$V_{DD} = 9 \sim 18\text{V}$ , $V_{IN} = V_{ENB} = 5\text{V}$	3.3	4.1	4.8	V
VDD 過電圧検出	$V_{DDOV}$	$V_{DD}$	-	18	22	25	V
スイッチングタイム	ton	IN→OUT1	測定回路図参照	-	16	100	$\mu\text{s}$
	toff			-	2	10	

注5: 標準値は  $V_{DD} = 12\text{V}$ 、 $T_j = 25^\circ\text{C}$  条件の値です。

注6: 本ICへの流入電流は“+”、本ICからの流出電流は“-”で表示しています。

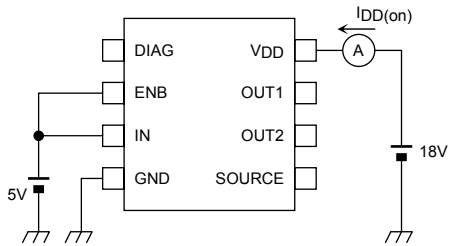
測定回路 1

消費電流  $I_{DD(off)}$



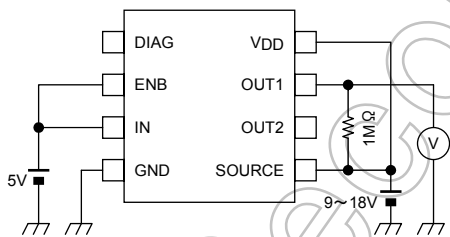
測定回路 2

消費電流  $I_{DD(on)}$



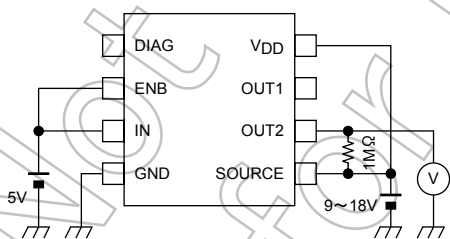
測定回路 3

出力電圧  $V_{OUT1H}$



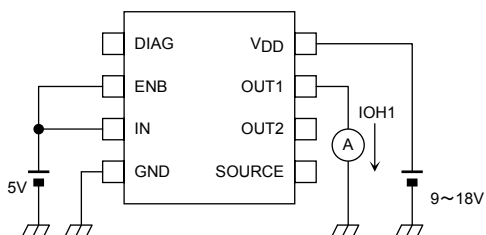
測定回路 4

出力電圧  $V_{OUT2H}$



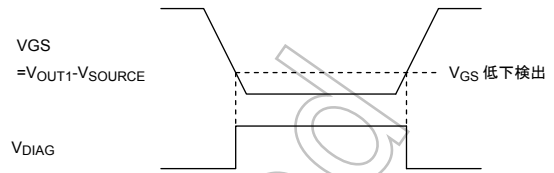
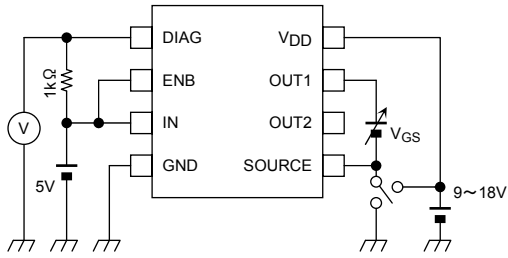
測定回路 5

OUT1 ハイレベル出力電流  $I_{OH1}$



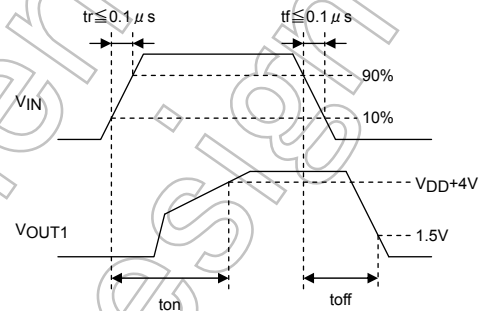
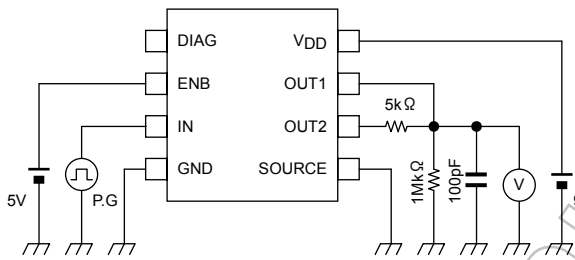
測定回路 6

V<sub>GS</sub> 低下検出



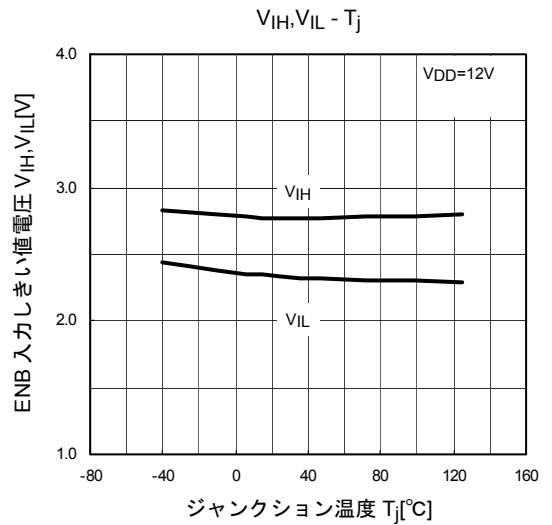
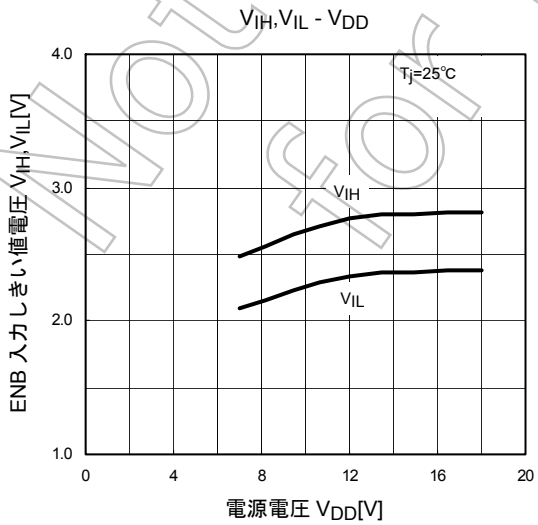
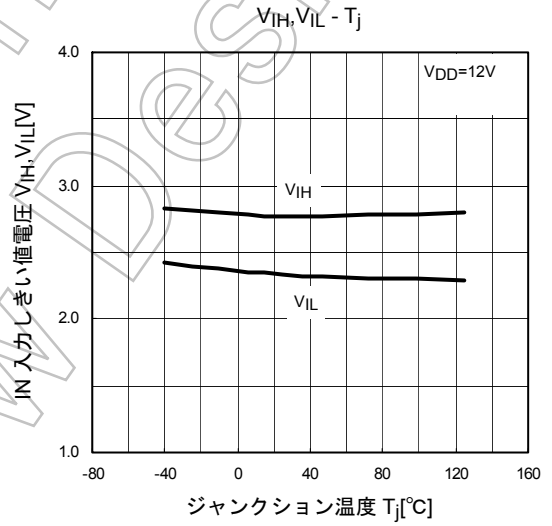
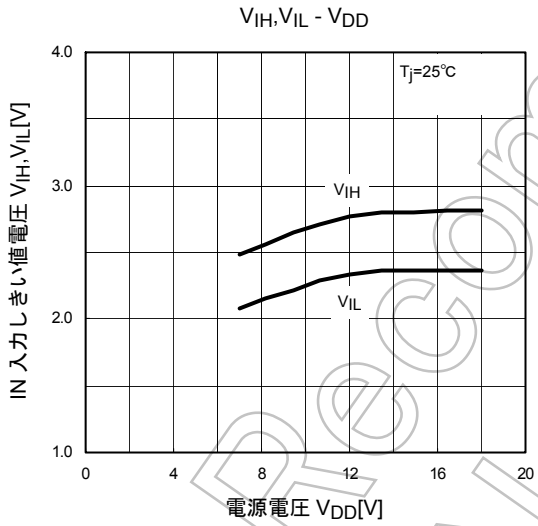
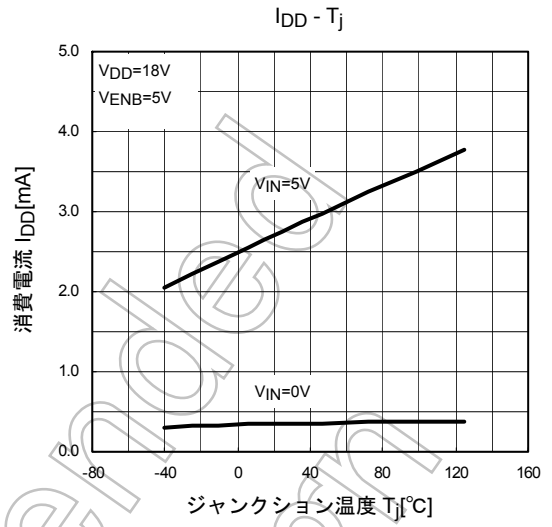
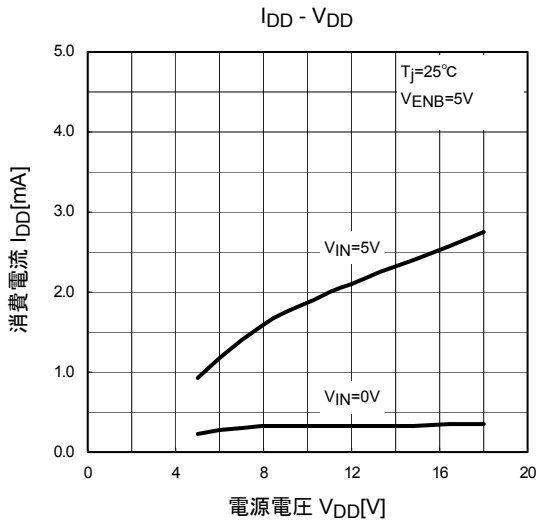
測定回路 7

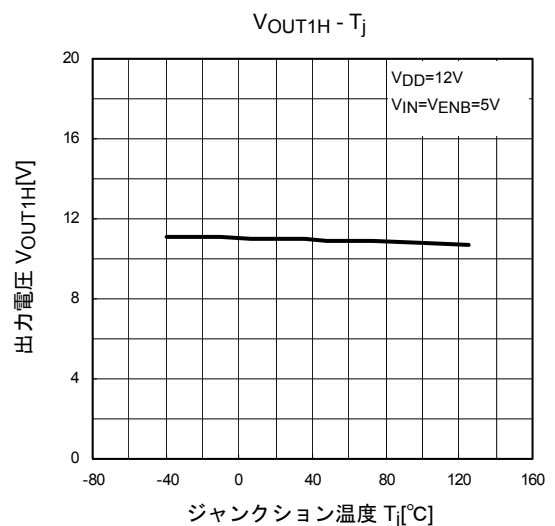
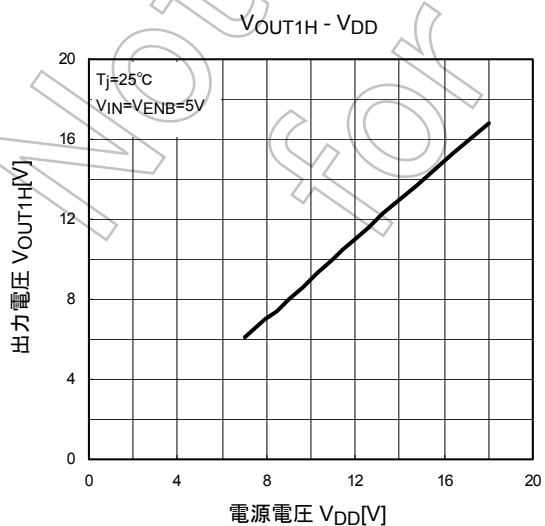
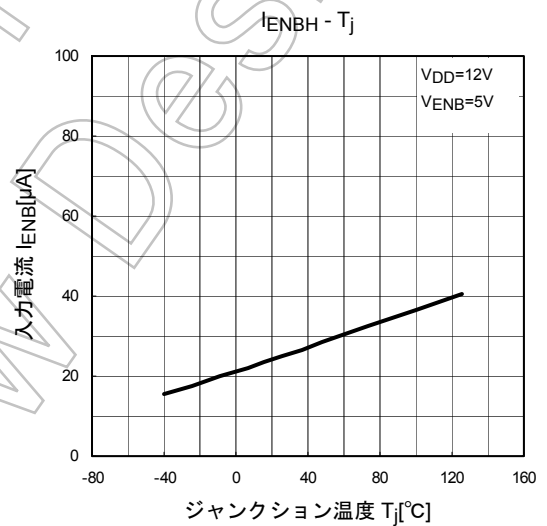
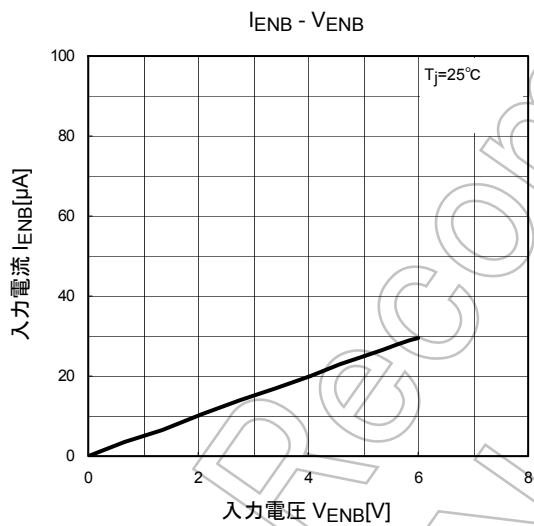
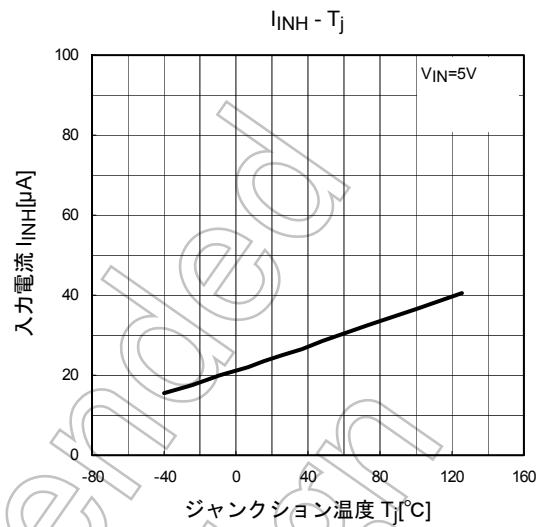
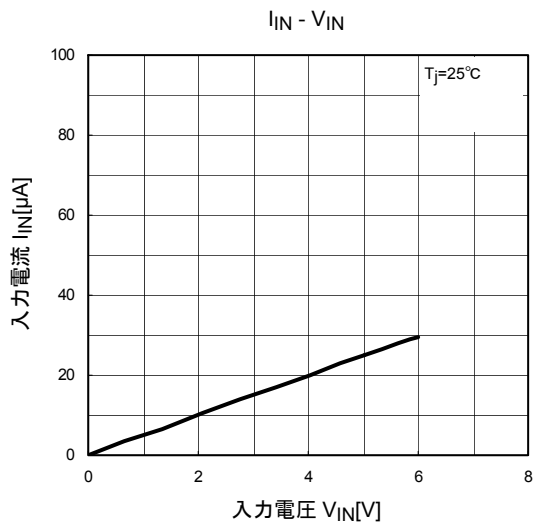
スイッチングタイム  $t_{on}$ ,  $t_{off}$

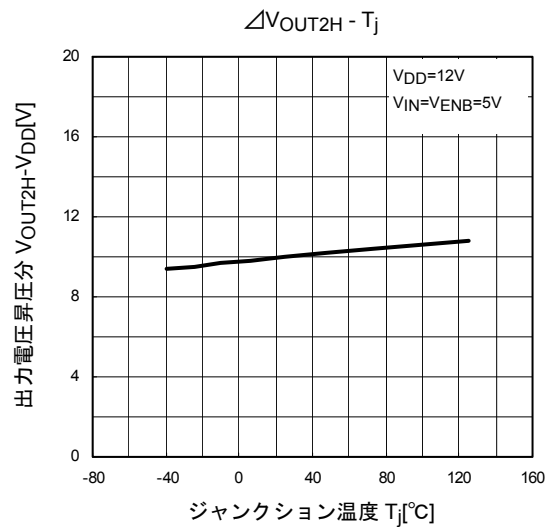
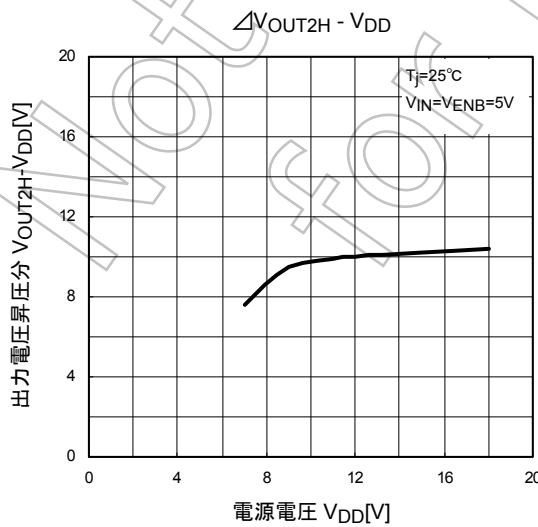
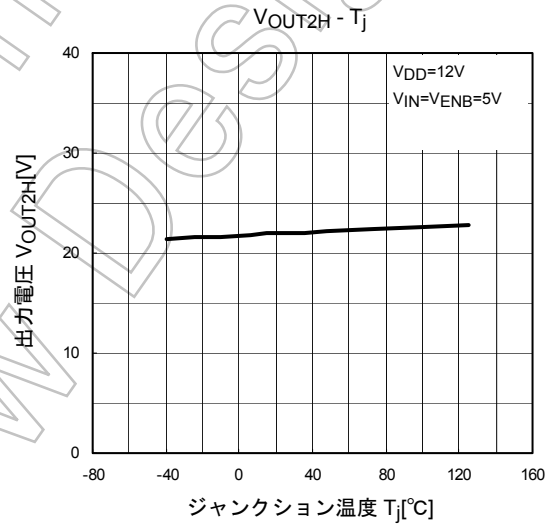
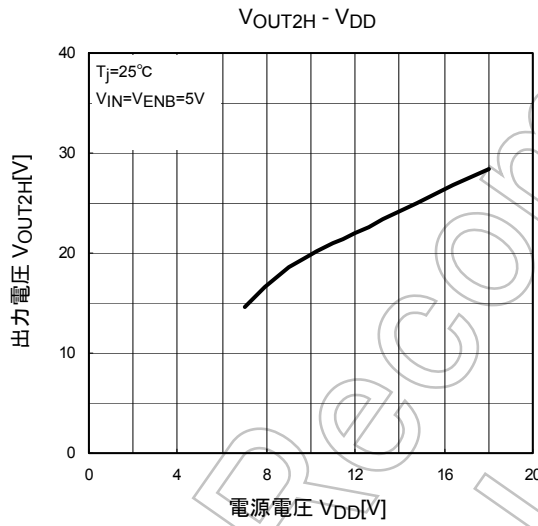
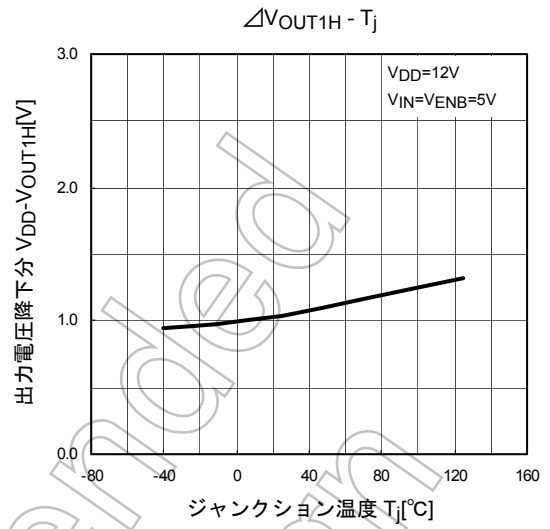
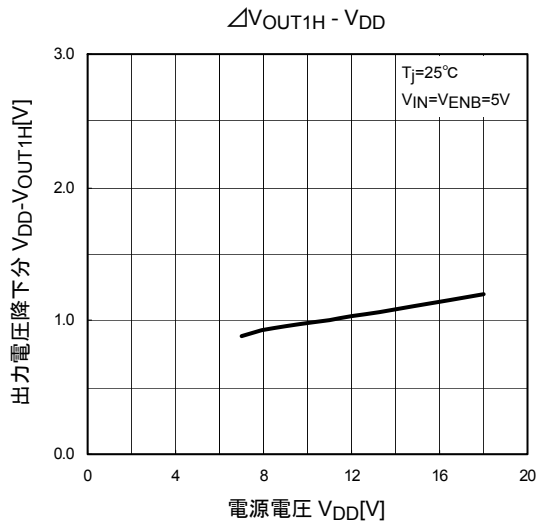


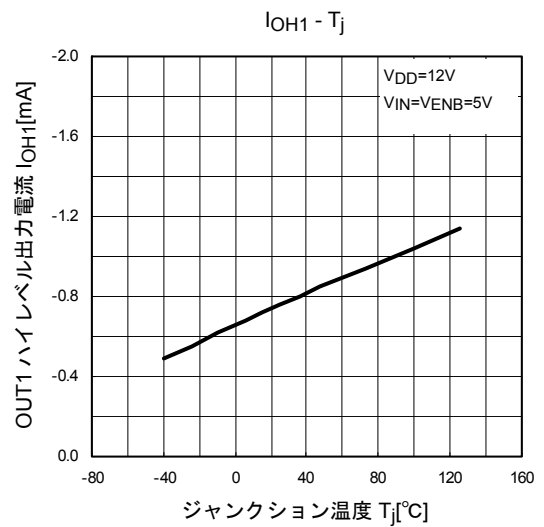
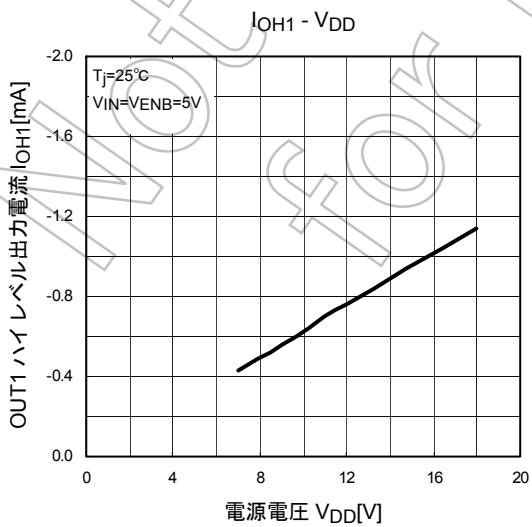
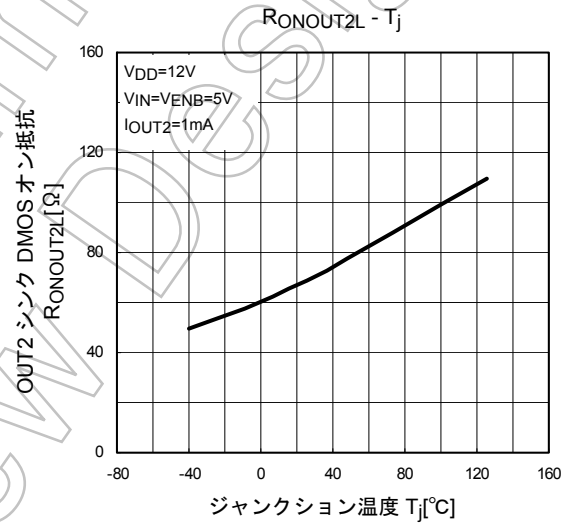
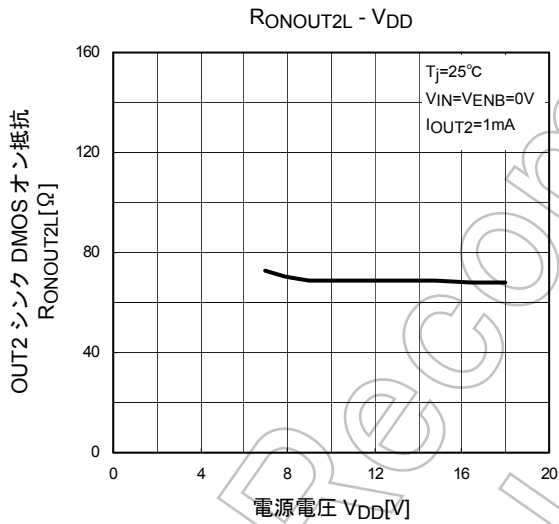
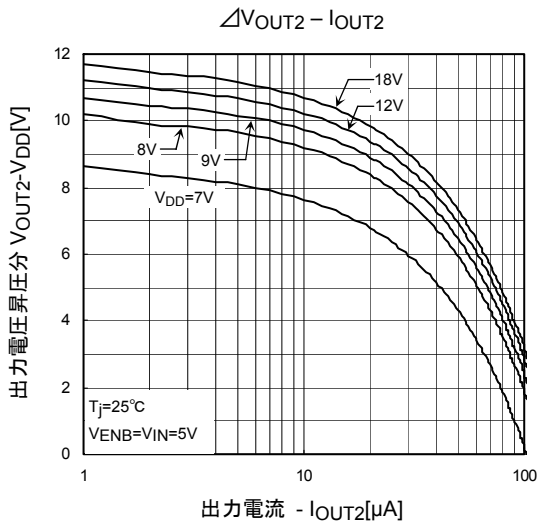
Not Recommended for New Design

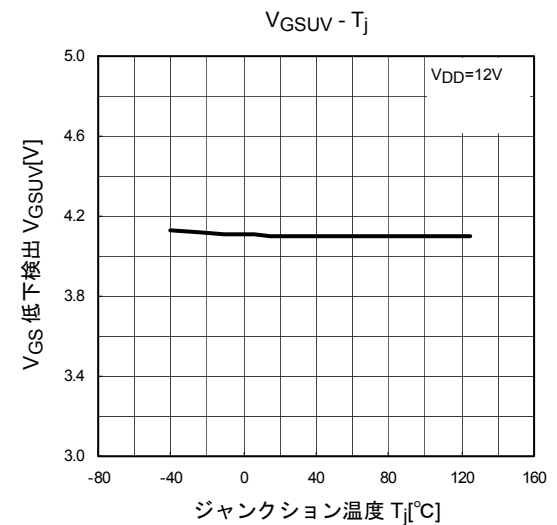
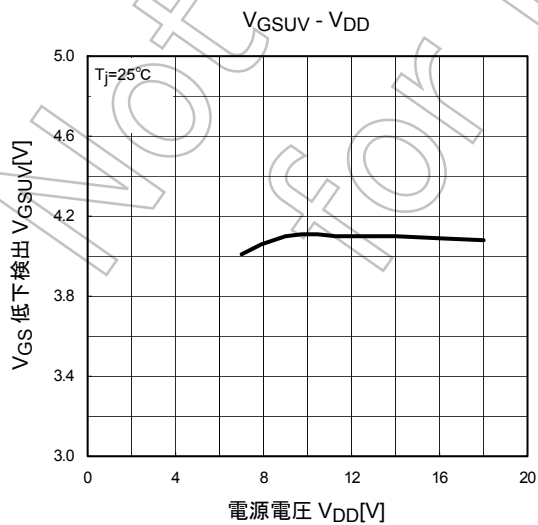
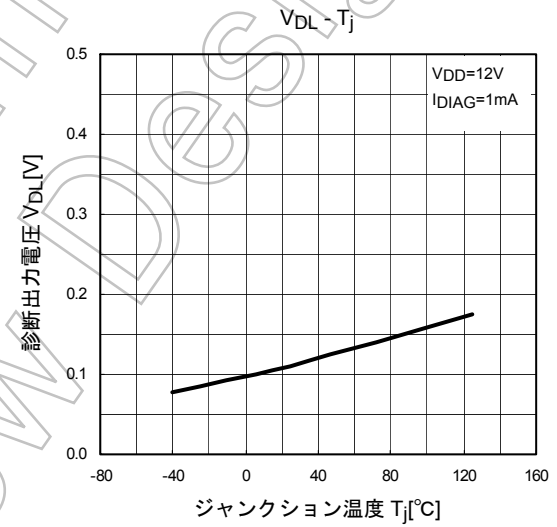
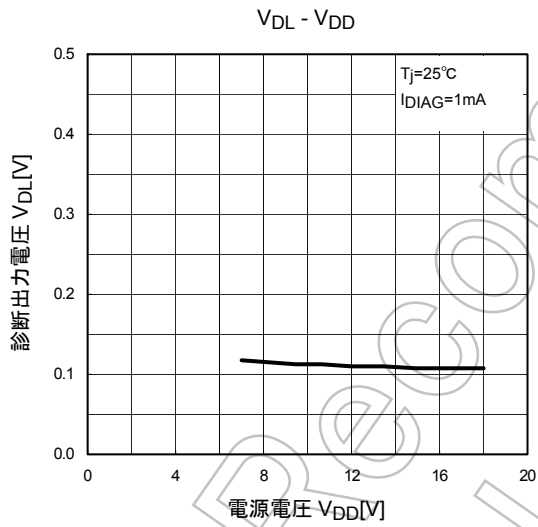
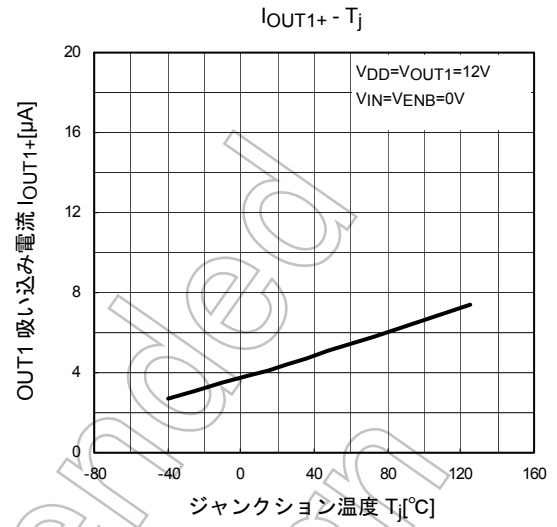


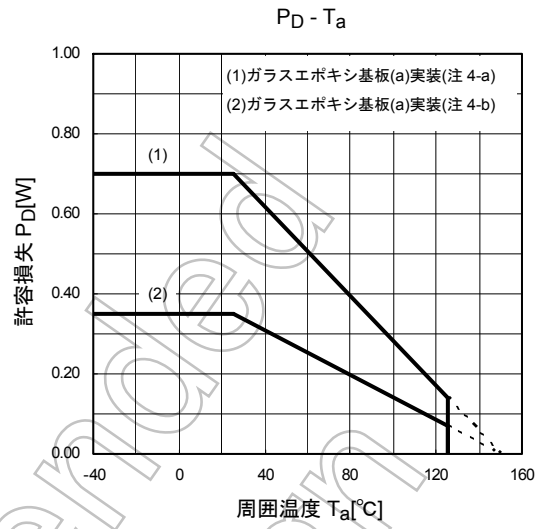
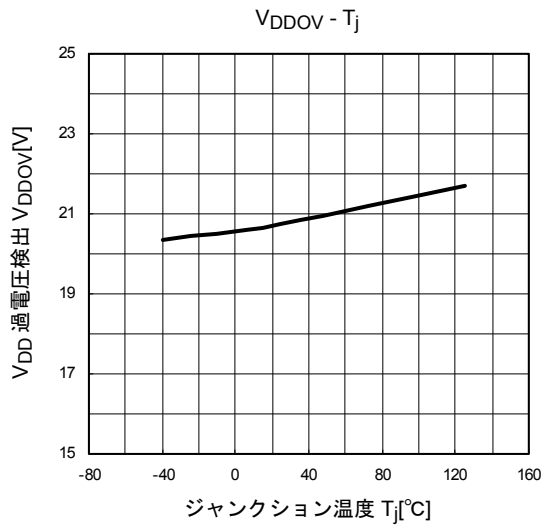










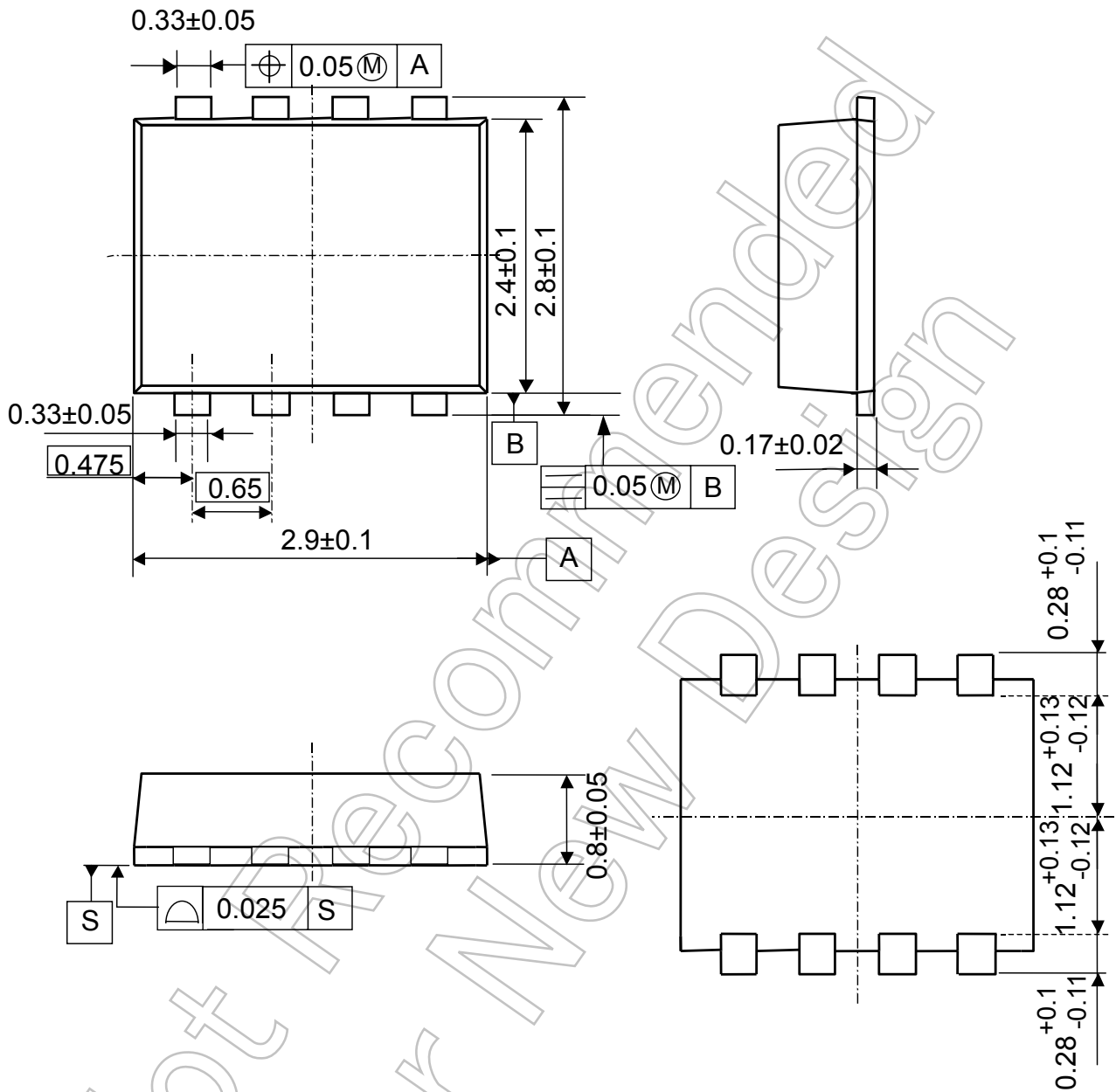


Not Recommended for New Designs

外形寸法図

SON8-P-0303-0.65

単位：mm



質量：0.017g (標準)

## 製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことを願います。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事情報の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。